

(12) NACH DEM VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES  
PATENTWESENS (PCT) VERÖFFENTLICHTE INTERNATIONALE ANMELDUNG

(19) Weltorganisation für geistiges Eigentum  
Internationales Büro



(43) Internationales Veröffentlichungsdatum  
15. September 2005 (15.09.2005)

PCT

(10) Internationale Veröffentlichungsnummer  
**WO 2005/084830 A1**

(51) Internationale Patentklassifikation<sup>7</sup>: **B08B 7/00**

(21) Internationales Aktenzeichen: **PCT/EP2005/001301**

(22) Internationales Anmeldedatum:  
9. Februar 2005 (09.02.2005)

(25) Einreichungssprache: **Deutsch**

(26) Veröffentlichungssprache: **Deutsch**

(30) Angaben zur Priorität:  
04004892.8 2. März 2004 (02.03.2004) **EP**

(71) Anmelder (für alle Bestimmungsstaaten mit Ausnahme von  
US): **SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT [DE/DE];**  
Wittelsbacherplatz 2, 80333 München (DE).

(72) Erfinder; und

(75) Erfinder/Anmelder (nur für US): **KRÜGER, Ursus**

[DE/DE]; Krampnitz Weg 11, 14089 Berlin (DE). **RE-  
ICHE, Ralph [DE/DE];** Bulgenbachweg 15, 13465 Berlin  
(DE). **STEINBACH, Jan [DE/DE];** Buchstrasse 8, 13353  
Berlin (DE).

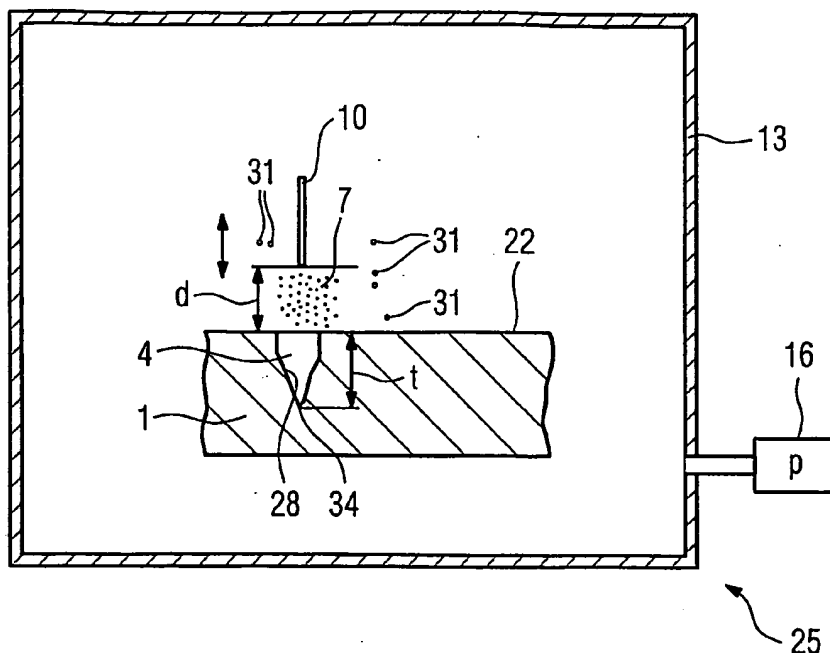
(74) Gemeinsamer Vertreter: **SIEMENS AKTIENGE-  
SELLSCHAFT;** Postfach 22 16 34, 80506 München  
(DE).

(81) Bestimmungsstaaten (soweit nicht anders angegeben, für  
jede verfügbare nationale Schutzrechtsart): AE, AG, AL,  
AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BW, BY, BZ, CA, CH,  
CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EC, EE, EG, ES,  
FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE,  
KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD,  
MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NA, NI, NO, NZ, OM, PG,  
PH, PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SM, SY, TJ,

[Fortsetzung auf der nächsten Seite]

(54) Title: **METHOD FOR PLASMA CLEANING OF A COMPONENT**

(54) Bezeichnung: **VERFAHREN ZUR PLASMAREINIGUNG EINES BAUTEILS**



(57) Abstract: Cracks are conventionally difficult to clean which often leads to damage to other regions of the component for clean-  
ing. According to the invention, a plasma cleaning method is used, whereby a pressure (p) and/or a separation (d) of an electrode  
(10) to the component (1) are varied, in order to achieve a plasma cleaning in the crack (4).

[Fortsetzung auf der nächsten Seite]

WO 2005/084830 A1



TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW.

PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

- (84) Bestimmungsstaaten (soweit nicht anders angegeben, für jede verfügbare regionale Schutzrechtsart): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LS, MW, MZ, NA, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), eurasisches (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), europäisches (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, MC, NL,

**Veröffentlicht:**

— mit internationalem Recherchenbericht

Zur Erklärung der Zweibuchstaben-Codes und der anderen Abkürzungen wird auf die Erklärungen ("Guidance Notes on Codes and Abbreviations") am Anfang jeder regulären Ausgabe der PCT-Gazette verwiesen.

(57) Zusammenfassung: Risse nach dem Stand der Technik lassen sich nur schwierig reinigen und führen oft zu einer Schädigung anderer Bereiche des zu reinigenden Bauteils. Bei dem erfindungsgemäßen Verfahren wird ein Plasmareinigungsverfahren angewendet, in dem ein Druck (p) und/oder ein Abstand (d) einer Elektrode (10) zu dem Bauteil (1) variiert wird, um ein Plasmareinigung in dem Riss (4) zu erzielen.